

Микросхемы КР580ИК80А

Э Т И К Е Т К А



Полупроводниковая интегральная микросхема КР580ИК80А
— 8-разрядное параллельное центральное процессорное устройство.

Микросхема выполнена в пластмассовом корпусе.

Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов

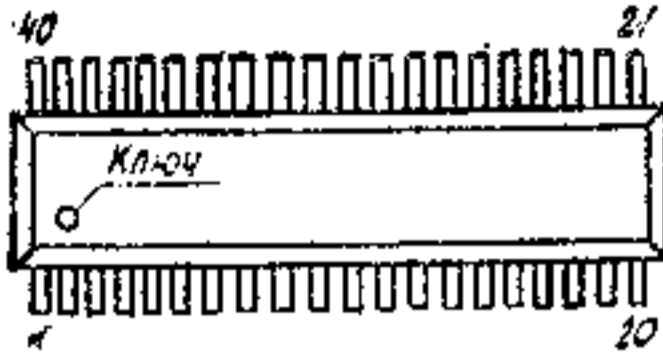


Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Наименование вывода	Обозначение вывода	Наименование вывода
1	A10	21	HL DA
2	0V	22	F1
3	D4	23	REA DV
4	D5	24	WAIT
5	D6	25	A0
6	D7	26	A1
7	D3	27	A2
8	D2	28	Исс ₁
9	D ¹	29	A3
10	D ⁰	30	A4
11	Исс ₃	31	A5
12	RESET	32	A6
13	HOLD	33	A7
14	IND	34	A8
15	E2	35	A9
16	INTE	36	A15
17	DBIN	37	A12
18	WR	38	A13
19	SYNC	39	A14
20	Исс ₂	40	A11

Основные электрические параметры при $T = 25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Норма		Приме- чание
	не менее	не более	
1. Выходное напряжение высокого уровня, В	3,7	—	1
2. Выходное напряжение низкого уровня, В	—	0,4	1
3. Ток потребления от источника питания 1, мА	—	50	2
4. Ток потребления от источника питания 2, мА	—	70	2
5. Ток потребления от источника питания 3, мА	—	1	2
6. Входной ток высокого уровня на управляющих входах, мкА	—1	1	3
7. Входной ток низкого уровня на управляющих входах, мкА	—1	1	3
8. Входной ток высокого уровня на фазных входах, мкА	—1	1	4
9. Выходной ток в состоянии „Выключено“, мкА	—10	10	5

- Примечания:**
1. При $I_{сс1} = 11,4 \text{ В}$, $I_{сс2} = 4,75 \text{ В}$, $I_{сс3} = \text{минус } 5,25 \text{ В}$,
 $I_{1H} = 3,3 \text{ В}$, $I_{1L} = 0,6 \text{ В}$, $I_{HF} = 10 \text{ В}$, $I_{LF} = 0,8 \text{ В}$,
 $f_F = 2,5 \text{ мГц}$, $C_L \leq 100 \text{ пФ}$.
 2. При $I_{сс1} = 12,6 \text{ В}$, $I_{сс2} = 5,25 \text{ В}$, $I_{сс3} = \text{минус } 4,75 \text{ В}$,
 $I_{1H} = 3,3 \text{ В}$, $I_{1L} = 0,6 \text{ В}$, $I_{HF} = 12,6 \text{ В}$, $I_{LF} = 0,8 \text{ В}$,
 $f_F = 2,0 \text{ мГц}$, $C_L \leq 100 \text{ пФ}$.
 3. При $I_{сс1} = 12,6 \text{ В}$, $I_{сс2} = 5,25 \text{ В}$, $I_{сс3} = \text{минус } 4,75 \text{ В}$,
 $I_{HF} = 12,6 \text{ В}$, $I_{FL} = 0,8 \text{ В}$, $f_F = 2,0 \text{ мГц}$
 4. При $I_{сс1} = 12,6 \text{ В}$, $I_{сс2} = 5,25 \text{ В}$, $I_{сс3} = \text{минус } 4,75 \text{ В}$,
 $I_{HF} = 12,6 \text{ В}$, $f_F = 2,0 \text{ мГц}$, $I_{FL} = 0,8 \text{ В}$
 5. При $I_{сс1} = 12,6 \text{ В}$, $I_{сс2} = 5,25 \text{ В}$, $I_{сс3} = \text{минус } 4,75 \text{ В}$,
 $I_{1H} = 3,3 \text{ В}$, $I_{1L} = 0,6 \text{ В}$, $I_{HF} = 12,6 \text{ В}$, $I_{FL} = 0,8 \text{ В}$,
 $f_F = 2,0 \text{ мГц}$, $C_L = 100 \text{ пФ}$

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Таблица 3

Наименование параметра, единица измерения	Норма			
	Предельно допу- стимый режим		Предельный, режим	
	не менее	не более	не менее	не более
Напряжение источника питания 1 на выводе 28, В	—	13,2	—	14
Напряжение источника питания 2 на выводе 20, В	—	5,25	—	5,5
Напряжение источника питания 3 на выводе 11, В	—5,25	—	—6	—

Напряжение высокого уровня импульсов фаз F1, F2 В	—	13	—	14
Напряжение низкого уровня импульсов фаз F1, F2 В	—0,3	—	—	—
Входное напряжение высокого уровня, В	—	5,25	—	6,0
Входное напряжение низкого уровня, В	—0,3	—	—	—
Напряжение высокого уровня, подаваемое на шины данных и адреса в режиме „HOLD“ и в период действия сигнала „RESET“, В	—	5,25	—	—
Напряжение низкого уровня, подаваемое на шины данных и адреса в режиме „HOLD“ и в период действия сигнала „RESET“, В	—0,3	—	—	—
Выходной ток высокого уровня, мА	—	0,1	—	0,1
Выходной ток низкого уровня, мА	—	1,8	—	2,0

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото —2,4980 г

Содержание цветных металлов.

Рамка выводная, плакированная алюминием

никеля—0,3 г

Сведения о приемке

Микросхема КР580ИК80А соответствует техническим условиям БКО.348.527 ТУ

Место для штампа ОТК

Указания по эксплуатации

Микросхемы должны применяться только в соответствии с их функциональным назначением в режимах и условиях, оговоренных техническими условиями.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов. Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником. Пайку выводов проводить, применяя припой ПОС-61 и флюс ФКСп. При эксплуатации микросхем необходимо применять меры защиты их от воздействия статистического потенциала—30В. Категория микросхем—2, вид климатического исполнения УХЛ. (В—при условии защиты микросхем в составе аппаратуры тремя слоями лака УР-231 ТУ 6-10-863-84).

Замену микросхем при ремонте аппаратуры, установку и извлечение микросхем из контактных приспособлений необходимо производить при отсутствии напряжения на выводах микросхемы.

Рекомендуется одновременная подача и отключение всех питающих напряжений на микросхему.

Допускается неодновременная подача питающих напряжений с соблюдением последовательности включения источников питания: $Исс_3 = -5В$, $Исс_2 = 5В$, $Исс_1 = 12В$. Отключение производится в обратном порядке.